

	<p><b>SIA416DJ-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA416DJ-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 11.3A SC70-6L</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA416DJ-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA416DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 11.3A SC70-6L
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	83 mOhm @ 3.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.3A (Tc)

SIA416DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA416DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA416DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIA416DJ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA414DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA418DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA414DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA415DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>
 <p><b>SIA414DJ-TI-E3</b> VISHAY SIA414DJ-TI-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIA417DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA418DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA415DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA416DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA416DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA416DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA416DJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA416DJ-T1-GE3
SIA416DJ-T1-GE3 Electronic	SIA416DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA416DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA416DJ-T1-GE3-Bild	SIA416DJ-T1-GE3-Teil
SIA416DJ-T1-GE3 Preis	SIA416DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA416DJ-T1-GE3 Bild	SIA416DJ-T1-GE3 Aktie	SIA416DJ-T1-GE3 Inventar
SIA416DJ-T1-GE3 Neu	SIA416DJ-T1-GE3 Original	SIA416DJ-T1-GE3 garantiert	SIA416DJ-T1-GE3 RFQ	SIA416DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited